

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

543175

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
5. August 2004 (05.08.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2004/066333 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01J

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/000559

(22) Internationales Anmeldedatum:

23. Januar 2004 (23.01.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 02 794.7 24. Januar 2003 (24.01.2003) DE

(71) Anmelder: NAWOTEC GMBH [DE/DE]; Industriestr. 1,  
64380 Rossdorf (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KOOPS, Hans, Wilfried, Peter [DE/DE]; Ernst-Ludwig-Strasse 16, 64372 Ober-Ramstadt (DE).

(74) Anwälte: BORCHERT, Uwe, R. usw.; Postfach 10 12 31, 80086 München (DE).

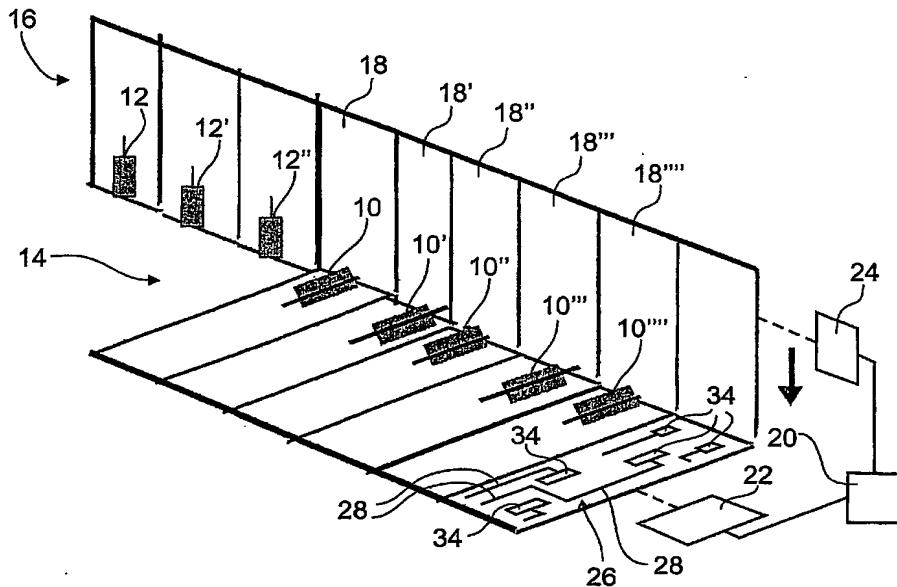
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING CORPUSCULAR RADIATION SYSTEMS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KORPUSKULARSTRAHLSYSTEMEN



WO 2004/066333 A2

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing corpuscular radiation systems (10-10'''', 12-12'''), whereby at least one first corpuscular radiation system (10-10''') is produced on a first substrate (14) by means of computer-controlled, corpuscular radiation-induced deposition, and at least one second corpuscular radiation system (12-12'') is produced on at least one second substrate (16) by the at least one first corpuscular radiation system (10-10''') by means of computer-controlled, corpuscular radiation-induced deposition. The inventive method can be used to produce a plurality of corpuscular radiation systems in a relatively short space of time.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY



TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**Veröffentlicht:**

- *ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts*

---

**(57) Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen (10-10 "", 12-12"), bei dem auf einem ersten Substrat (14) mindestens ein erstes Korpuskularstrahlsystem (10-10 "") mittels Rechnergeführter korpuskularstrahlinduzierter Deposition und auf mindestens einem zweiten Substrat (16) mindestens ein zweites Korpuskularstrahlsystem (12-12") von dem mindestens einen ersten Korpuskularstrahlsystem (10-10 "") mittels Rechnergeführter korpuskularstrahlinduzierter Deposition erzeugt wird. Mit dem erfindungsgemässen Verfahren können eine Vielzahl von Korpuskularstrahlsystemen in relativ kurzer Zeit produziert werden.

RECEIVED AT  
22 JUL 2005

5

## B E S C H R E I B U N G

10

**Verfahren und Vorrichtung  
zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen**

15

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen gemäß der im Anspruch 1 angegebenen Art und eine entsprechende Vorrichtung gemäß der im Anspruch 20 angegebenen Art.

20

Korpuskularstrahlsysteme umfassen insbesondere Elektronenstrahl- oder Ionenstrahlsysteme. Im folgenden werden beispielhaft Elektronenstrahlsysteme, deren Anwendungen und Nachteile erläutert. Dies ist jedoch nicht einschränkend zu verstehen. Vielmehr gelten die folgenden Erläuterungen ebenso für andere Korpuskularstrahlsysteme wie beispielsweise die erwähnten Ionenstrahlsysteme.

25

Elektronenstrahlsysteme werden beispielsweise in der Halbleitertechnologie, Nanoanalytik, Bio-Nano-Physik, Mikro-Optik und Nano-Elektronik eingesetzt. Sie können insbesondere zur Herstellung von Nanostrukturen wie zum Beispiel der Elektronenstrahl-induzierten lithographischen Nanostrukturierung von Oberflächen angewandt wer-

30

**BESTÄTIGUNGSKOPIE**

den. Ionen- und Elektronenstrahlsysteme werden auch zur Reparatur von Photomasken, phasenschiebenden Photomas-ken und NGL-Masken für die Halbleiterindustrie verwen-det. Mit Elektronenstrahlen können auch integrierte 5 Schaltungen direkt auf einen Halbleiterwafer geschrie-ben und auch dort repariert werden. Vorzugsweise wird dies bei integrierten Schaltungen mit Strukturabmessun-gen im nm-Bereich praktiziert, wo die bisher eingesetz-te Optische und Ionenstrahl-Lithographie an physikali-sche Grenzen stößt. 10

Ein Elektronenstrahlsystem umfasst eine Vielzahl von elektronischen Komponenten, wie beispielsweise eine Strahlstromstabilisierung, eine Strahlablenkung, eine 15 Fokusierungsautomatik mit Hilfe von programmierten Se-quenzen, eine Elektronenstrahl-Ablenkung und - Verstärkung und eine Sekundärelektronenstrahl-verstärkung. Diese Komponenten werden bisher überwie-gend in Form von Einzelplatinen mit diskreten Schalt- 20 kreisen aufgebaut, die derart programmierbar sind, dass die vorgenannten Funktionen ausgeführt werden können.

Um Elektronenstrahlsysteme zu verkleinern, ist es be-kannt, Einzelelemente von Elektronenstrahlsystemen mit-tels Elektronenstrahl-induzierter Deposition aufzubau-en, wie beispielsweise der Aufbau von Feldelektronen-emittern, Feldemissionskathoden mit Extraktor und Fo-kussierlinsen sowie von Drahtlinsen für eine elektro-statische Fokussierung und Ablenkung. Die Herstellung 25 einer elektrostatischen Miniaturlinse mittels Elektro-nenstrahl-induzierter Deposition ist beispielsweise in der DE 44 35 043 A1 beschrieben. Aus der DE 44 16 697 A1 ist es bekannt, für einen flachen 30

Farbbildschirm parallel eine Vielzahl mikro-  
miniaturisierter Elektronenstrahl-Emittersysteme mit  
Hilfe einer korpuskularstrahlinduzierten Deposition auf  
5 einem mit Leiterbahnen konventionell strukturierten  
Grundmaterial aufzubringen.

Zur Miniaturisierung wurden Elektronenstrahlsysteme  
auch aus mechanischen Einzelteilen zusammengebaut, die  
10 aber nicht mit einer kalten Feldelektronenemission,  
sondern einer heißen Elektronenemission betrieben wer-  
den. Mittlerweile wurde auch damit begonnen, miniaturi-  
sierte Elektronenstrahlsäulen zu bauen. Verschiedene  
Forschungsgruppen beschäftigen sich auch damit, Elekt-  
15 ronenquellen aus Kohlenstoff-Nanoröhren und anderen E-  
mittern, wie z.B. dotierte Siliziumspitzen mit transis-  
torgesteuertem Emissionsstrom aufzubauen, die auf einem  
Halbleiterchip in einer Prozessschrittfolge hergestellt  
werden.

20 Nachteilig an den vorgenannten Verfahren ist jedoch,  
dass die Erzeugung einer Vielzahl von miniaturisierten  
Korpuskularstrahlsystemen sehr lange dauert, d.h. eine  
sehr lange Produktionszeit benötigt, da jedes System  
25 einzeln sukzessive aufgebaut bzw. erzeugt wird.

Nachteilig ist auch, dass die Herstellungsprozess-  
schritte der Halbleiterfertigung so großen Toleranzen  
unterliegen, dass eine gleichartige Emissions-  
Charakteristik der Feldemitter nicht erreicht wird.

30 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfah-  
ren zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen und  
eine entsprechende Vorrichtung anzugeben, welche den

Aufbau einer Vielzahl von miniaturisierten Korpuskularstrahlsystemen in relativ kurzer Zeit ermöglichen.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Herstellung  
5 von Korpuskularstrahlsystemen mit den Merkmalen nach  
Anspruch 1 und durch eine entsprechende Vorrichtung mit  
den Merkmalen nach Anspruch 20 gelöst. Bevorzugte Aus-  
gestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den abhän-  
gigen Ansprüchen.

10

Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung besteht darin,  
eine große Anzahl von miniaturisierten Korpusku-  
larstrahlsystemen durch eine Art Selbstreproduktion zu  
ermöglichen. Dies kann dadurch erreicht werden, dass  
15 bereits erzeugte Korpuskularstrahlsysteme zum Erzeugen  
weiterer Korpuskularstrahlsysteme mittels korpusku-  
larstrahlinduzierter Deposition eingesetzt werden.

Beispielsweise können gemäß der Erfindung mit Hilfe der  
20 Elektronenstrahl-induzierten Deposition unter Rechner-  
führung miniaturisierte Elektronenstrahlsysteme in gro-  
ßer Zahl hergestellt werden. Als Basis und Grundlage  
kann hierbei eine durch Lithographie in VLSI-Technik  
hergestellte Grundschaltung dienen, in welche hinein  
25 mit der Elektronenstrahl-induzierten Deposition die  
Funktionselemente für ein weiteres miniaturisiertes E-  
lektronenstrahlsystem aufgebaut werden. Dieses miniatu-  
risierte System wird dann, nachdem es eine Funktions-  
prüfung bestanden hat, weiterverwendet, um wiederum in  
30 einen ebenfalls vorher vorbereiteten Basis-Chips hinein  
durch Elektronenstrahl-induzierte Deposition die funk-  
tionellen Elemente für ein gleichartiges Elektronen-  
strahlsystem aufzubauen. Eine wesentliche Eigenschaft

des Elektronenstrahlsystems besteht darin, einen feinen Elektronenstrahl auf ein Substrat zu fokussieren und dort durch Zufuhr von organometallischen Verbindungen wiederum Strukturen durch Elektronenstrahl-induzierte 5 Deposition zu erzeugen. Das erfindungsgemäße Verfahren zur Selbstreproduktion von Elektronenstrahlsystemen kann nun in einem ersten Schritt zur Verdoppelung der Anzahl von Elektronenstrahlsystemen den vorher beschriebenen Prozess nutzen, a) um eine Tochtergenerati- 10 on von Elektronenstrahlsystemen zu erzeugen und b) um die „Tochter“- Elektronenstrahlsysteme zusammen mit dem „Mutter“- Elektronenstrahlsystem parallel einzusetzen, um daraufhin eine zweite Töchtergeneration von nunmehr zwei Elektronenstrahlsystemen parallel aufzubauen. Die- 15 se neu aufgebauten Elektronenstrahlsysteme werden dann wieder zu den bereits bestehenden Elektronenstrahlsys- temen parallel geschaltet, wodurch vier Elektronen- strahlsysteme erhalten werden, die gemeinsam eingesetzt werden, um in vorbereitete Basis-Chips auf einem Sub- 20 strat Funktionselemente von weiteren vier Elektronen- strahlsystemen parallel und gleichzeitig aufzubauen, und so fort.

Mit der Erfindung wird die Möglichkeit eröffnet, ein 25 exponentielles Wachstum der Anzahl der Korpusku- larstrahlsysteme zu erzielen. Beispielsweise werden nach fünf Generationen 32 funktionsfähige miniaturisierte Korpuskularstrahlsysteme erhalten, die erprobt und funktionsbereit sind. Nach zehn Tochtergenerationen 30 sind bereits 1024 derartige miniaturisierte Systeme und nach 20 Tochtergenerationen 1 Mio. funktionierende Kor- puskularstrahlsysteme erhalten worden. Insbesondere schaltet man die derart erzeugten Korpuskularstrahl-

systeme in einen Block zusammen und setzt sie als Strahlmatrix mit z.B. bis zu 1 Mio. parallel produktiv wirkenden Korpuskularstrahlen ein, so erhält man mit Vorteil neuartige Produktionsgeräte zur Herstellung von

5 in der Einzelherstellung zu teuren neuen Produkten.

Dies wird durch die Tatsache verursacht, dass im Einzelstrahl-Herstellungsverfahren die Produkte eine hohe Herstellungszeit haben und damit hohe Herstellungs-Elektronenstrahl-Maschinenkosten von z.B. mehreren Minuten und damit nur unwirtschaftlich hergestellt werden 10 könnten. Beispiele solcher Produkte sind eine Widerstandsmatrix der Detektorelemente für eine flache Kamera für Multimedia-Anwendungen oder eine Emitter- und Extraktor-Anordnung für die Bildpunkt-Strahlungsquellen 15 für flache Feldemittorelektronenquellen, die in Flachbildschirmen Verwendung finden, und die auch mit Vorteil in einem Hochstrom-Schalter mit niedriger Schaltspannung für die Energieübertragungstechnik Anwendung finden.

20

Konkret betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen, bei dem auf einem ersten Substrat mindestens ein erstes Korpuskularstrahlsystem mittels korpuskularstrahlinduzierter Deposition und auf mindestens einem zweiten Substrat mindestens ein zweites Korpuskularstrahlsystem von dem mindestens einen ersten Korpuskularstrahlsystem mittels korpuskularstrahlinduzierter Deposition erzeugt wird.

25 30 Anschließend kann auf dem ersten Substrat mindestens ein weiteres erstes Korpuskularstrahlsystem von dem mindestens einen zweiten Korpuskularstrahlsystem mit-

tels korpuskularstrahlinduzierter Deposition erzeugt werden.

5 Vorzugsweise werden abwechselnd erste und zweite Korpuskularstrahlsysteme von den bereits auf den Substraten existierenden zweiten bzw. ersten Korpuskularstrahlsystemen erzeugt.

10 Insbesondere werden ein erstes und ein zweites Substrat derart zueinander versetzt angeordnet, dass den auf einem Substrat bereits existierenden Korpuskularstrahlsystemen freie Flächen des anderen Substrats gegenüberliegen, so dass die Korpuskularstrahlsysteme des einen Substrats Korpuskularstrahlsysteme auf den freien Flächen des anderen Substrats erzeugen können.

15 Um die für die Herstellung erforderliche Genauigkeit zu erzielen, werden die Substrate vorzugsweise von einem Rechner gesteuert positioniert.

20 Eine besonders hohe Positionierungsgenauigkeit ermöglichen Piezoelemente, mit denen insbesondere über einen x-y-z-Verschiebetisch die Substrate zueinander positioniert werden können. Auch mechanische Verschiebetische, 25 die mit Linearmaßstäben in ihrer Bewegung verfolgt werden erfüllen die Präzisionsanforderung für die Platzierung der System-Komponenten.

30 Jedes Korpuskularstrahlsystem wird vorzugsweise nach seiner Erzeugung elektrisch getestet, um mögliche Defekte bereits während des Herstellungsprozesses zu erkennen.

In einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge-  
mäßen Verfahrens werden vor der Erzeugung von Korpusku-  
larstrahlsystemen auf den Substraten Schaltungselemen-  
te, insbesondere Verdrahtungselemente erzeugt, mit de-  
5 nen die erzeugten Korpuskularstrahlsysteme zumindest  
teilweise elektrisch verbunden und angesteuert werden.

10 Insbesondere werden Korpuskularstrahlsysteme auf An-  
schlusspunkten, die auf einem Substrat vorgesehen sind,  
erzeugt.

Eine besonders effiziente Herstellung kann dadurch er-  
zielt werden, dass Korpuskularstrahlsysteme auf einem  
Substrat kammartig nebeneinander angeordnet werden.

15 Insbesondere bestehen wegen der geringen Abmessungen  
der Systeme Abstände von weniger als 50 µm zwischen den  
Systemen.

20 Dabei werden die Zwischenräume zwischen den Systemen  
mit Vorteil für die elektrostatische Abschirmung der  
Einzelsysteme gegeneinander mit Hilfe von auf definier-  
tem Gleichspannungs- oder Wechselspannungspotential lie-  
genden Elektroden und Leiterbahnen verwendet.

25 Vorzugsweise führen erste und/oder zweite Korpusku-  
larstrahlsysteme eine Bildauswertung von Bildsignalen  
durch, die durch Rasterung erzeugt werden, um den Pro-  
duktionsprozess visuell zu überwachen.

30 Sowohl Fokussierung, Stigmatisierung und Ablenkung ei-  
nes Korpuskularstrahls werden vorzugsweise in einem au-  
tomatischen Ablauf erfolgen und für jedes Korpusku-

larstrahlsystem kann eine individuelle Fokussierung durchgeführt.

Die Deposition wird in einer bevorzugten Ausführungs-  
5 form mit ionenstrahlinduzierter Deposition durchge-  
führt. Alternativ dazu wird die Deposition mit Elektro-  
nenstrahlen verwendet.

Vorzugsweise erfolgt die Deposition für das erste her-  
10 zustellende Korpuskularstrahlsystem mit rastersonden-  
mikroskopischer Deposition mit Niederspannung bei-  
spielsweise von etwa 100 V bis etwa 40 kV.

Die Korpuskularstrahlsysteme werden vorzugsweise in  
15 Gruppen von einem Steuersystem umfassend eine Steuer-  
und Programmierelektronik angesteuert und kontrolliert.

Bis zu einer bestimmten Anzahl ist es vorteilhaft, die  
Korpuskularstrahlsysteme vollständig konfiguriert auf-  
20 zubauen und dann durch geeignete Zuführung von Gasen  
zum Aufbau weiterer Korpuskularstrahlsysteme als paral-  
lel arbeitende Blöcke von Korpuskularstrahlsystemen  
einzusetzen.

25 Insbesondere werden Einzelkämme von Korpuskularstrahl-  
systemen reproduziert und zu Fertigungssystemen zusam-  
mengesetzt.

30 Die Blöcke können hierbei gemeinsam produziert werden,  
ohne dass sie weiterhin zusammengesetzt werden müssen.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die  
Korpuskularstrahlsysteme mit ihren Korpuskularstrahl-

Achsen etwa senkrecht zur Oberfläche des Substrats oder der Substrate angeordnet. Insbesondere umfassen die Korpuskularstrahlsysteme eine oder mehrere Feldemitter-Elektronenquelle(n) mit wenigstens einem Extraktor, 5 welcher als Rundlinse oder Quadrupol aufgebaut ist, und einer Fokussierungsleitung, welche ebenfalls als Rundlinse oder Quadrupol aufgebaut ist. Die Anordnung aus den Rundlinsen bzw. Quadrupolen ermöglicht eine Steuerung des Emissions-Stromes, die Fokussierung und die Ablenkung des Korpuskularstrahles in x-y-Richtung durch eine 10 rechnergesteuerte Einstellung der Versorgungsspannung der Rundlinsen- bzw. Quadrupol-Elektroden.

Insbesondere kann das Rundlinsen- bzw. Quadrupolsystem 15 durch Wahl der Spannungen an den Elektroden den Korpuskularstrahl an- und abschalten. Durch Anlegen der Ablenkspannungen an den Extraktor und die Fokussierleitung wird zudem der Elektronenstrahl zeilenförmig gerastert, im Spiral-Raster oder mit anderen zufälligen 20 oder gezielt gewünschten Koordinaten-Werten oder gezielt von Punkt zu Punkt bewegt.

Vorzugsweise sind um ein Korpuskularstrahlsystem Drähte, die Sekundärelektronen detektieren, und/oder Metall-Flächen angeordnet, welche die von dem Primärstrahl bzw. Korpuskularstrahl auf dem gegenüberliegenden Substrat erzeugten Sekundärelektronen aufnehmen. 25 Die Drähte bzw. Metall-Flächen verstärken die Sekundärelektronen in der Ausführungsform eines offenen Multiplikers und führen sie einem Bildsignal-Anzeigegerät 30 synchron zur Ablenkung oder einer Anzeige zu.

Insbesondere werden die Bildsignale und Sekundärsignale der Sekundärelektronen zur Prozeßsteuerung und Bildanzeige verwendet.

5 Die Strahlen der Korpuskularstrahlsysteme werden vorzugsweise zum Aufbau weiterer Korpuskularstrahlsysteme, Tochtersysteme oder Strahlquellen verwendet, die insbesondere auf einer in einem vorgegebenen Abstand angeordneten, über einen x-y-z-Verschiebetisch positionierbaren vorstrukturierten Halbleiterschaltung hergestellt werden. Die Halbleiterschaltung wird hierbei vorzugsweise durch Vorstrukturierung mit Anschläßen, Depositions-Fusspunkten und Systemelektronik in Form von Halbleiterschaltungen hergestellt.

10

15 Insbesondere ist eine erzeugte neue Tochterstruktur gleichartig zur Vervielfältigung der Mutter-Anordnung ausgeführt.

20 In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Tochterstruktur andersartig, aber ebenfalls korpuskularstrahlspezifisch aufgebaut, um andersartige Korpuskularstrahl-Anwendungen in mehrfacher Form auf den Substraten zu erzeugen und zur Funktion zu bringen, z.B. die vom Erfinder patentierten Mikroröhren für Elektronenverstärker im THz-Bereich, für Schaltungen für Bit-Fehler-Raten Messplätze für die Telekommunikation im oberen GHz Bereich oder für

25 Hochstrom-Elektronenquellen für die schnelle leistungsarme Schaltung von sehr hohen Strömen für die Energieverteilung.

30

Um die Deposition überall in gleicher Weise zu ermöglichen werden die zur Deposition erforderlichen Gase vorzugsweise zwischen gegenüber angeordneten Substraten mit ausreichend hohem Druck eingebracht.

5

Um zu verhindern, dass bei der Deposition auf der Tochterebene erzeugte Ionen auf der Mutterebene Deponieren, und umgekehrt, wird bei der Wahl der Spannungen in den Systemen Sorge getragen, dass ein Ionenspiegel-Effekt 10 eintritt, welcher diese Ionen von den empfindlichen Strukturen der Mutter-Ebene repsektive Tochterebene fern hält und sie durch Verwendung geeigneter Potentiale gezielt auf dafür vorgesehenen geeigneten Stellen 15 sammelt und unschädlich macht. Solche Stellen sind zum Beispiel Linsenelektroden oder vorgefertigte Auffangflächen, die auf gegenüber dem Auftreff-Ort der Primärelektronen negativem Potential liegen.

Die Substrate werden vorzugsweise rechnergesteuert 20 geneinander verschoben, so dass ebenfalls auf den Substraten befindliche und durch vorstrukturierende Lithographie und Lithographieverfahren hergestellte Teststrukturen es ermöglichen, erzeugte Tochterstrukturen 25 oder Spezialstrukturen in ihrer Eigenschaft zu vermes- sen und zu kalibrieren.

Durch Verdoppelung der getesteten und gegebenenfalls 30 durch Reparatur wieder funktionsfähig gemachten Strukturen werden diese in exponentiell wachsenden Zahlen erzeugt.

Die vielfach erzeugten Korpuskularstrahlsysteme werden vorzugsweise zur ökonomischen Herstellung von einzel-

nen, von in Gruppen durch Aufteilung der Flächen oder von flächigen Anordnungen derartiger Systeme eingesetzt.

5 Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen mit einem ersten Substrat und mindestens einem zweiten Substrat, wobei sich auf dem ersten Substrat mindestens ein mittels korpuskularstrahlinduzierter 10 Deposition erzeugtes erstes Korpuskularstrahlsystem befindet.

15 Insbesondere sind das erste und das mindestens zweite Substrat derart zueinander versetzt angeordnet, dass den auf einem Substrat bereits existierenden Korpuskularstrahlsystemen freie Flächen des anderen Substrats gegenüberliegen, so dass die Korpuskularstrahlsysteme des einen Substrats Korpuskularstrahlsysteme auf den freien Flächen des anderen Substrats erzeugen können.

20 In einer bevorzugten Ausführungsform zeichnet sich die Vorrichtung durch einen Rechner aus, der programmtechnisch eingerichtet ist, um die Anordnung der Substrate insbesondere über einen Verschiebetisch in x-y-z- 25 Richtung zu steuern.

30 Ferner werden vorteilhafterweise Piezoelemente an den Substraten vorgesehen, um diese zueinander mit hoher Präzision elektrisch gesteuert und vermessen zu positionieren.

Während der Herstellung wird vorzugsweise die Funktionsfähigkeit der Korpuskularstrahlsysteme überprüft

durch vorgesehene Testmittel, wie Bildwiedergabe, elektrische Strom- und Spannungsdetektion und Anzeige, und andere Anzeigen, die zum Testen jedes Korpuskularstrahlsystems auf den Substraten ausgebildet und elektrisch angeschlossen sind.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das erste und zweite Substrat ein Halbleiter, insbesondere Silizium. In diesem Fall werden mittels Halbleiterherstellungsverfahren, wie diese auch zur Produktion von integrierten Schaltungen angewandt werden, elektronische Komponenten auf den Substraten für die Korpuskularstrahlsysteme erzeugt. Falls hohe Spannungen in den Korpuskularstrahlsystemen erforderlich sind, wird mit Vorteil die elektronische Steuer- und Vermessungsschaltung auf einem isolierenden Substrat wie Glas oder Keramik mit Halbleitertechnischen Prozessen hergestellt.

Insbesondere wird vorteilhafterweise das Substrat Schaltungselemente, insbesondere Verdrahtungselemente aufweisen, mit denen Korpuskularstrahlsysteme zumindest teilweise elektrisch verbunden werden.

Die Schaltungselemente sind beispielsweise insbesondere rechnergesteuerte Korpuskularstrahlstromregler, Heizstromregler, Korpuskularstrahlablenkverstärker, Blendenablenkverstärker, Rastergenerator, Funktionsgenerator mit Speicher, Linseneinstellmittel, Linsenspannungsverstärker, Bildsignalverstärker, Astigmatismus-Spannungsverstärker und/oder Ablenkungsspannungsverstärker.

Typischerweise weist ein Substrat mindestens eine Fläche mit einer Breite von etwa 2 µm bis etwa 2500 µm und einer Länge von etwa 10 µm bis zu etwa 100 mm für ein Korpuskularstrahlsystem auf.

5

Ferner weist ein Substrat in einer bevorzugten Ausführungsform Anschlusspunkte für Korpuskularstrahlsysteme auf, beispielsweise metallisierte elektrische Kontaktpunkte zum Anschliessen von Komponenten der Korpuskularstrahlsysteme.

10

Vorzugsweise sind Korpuskularstrahlsysteme auf einem Substrat kammartig nebeneinander angeordnet, was produktionstechnisch besonders vorteilhaft ist, da sich die Substrate Seite an Seite anordnen lassen und alle Korpuskularstrahlsysteme eines Substrats dann zur Erzeugung von Korpuskularstrahlsystemen auf dem gegenüberliegenden ebenfalls kammartigen Substrat gleichzeitig arbeitend eingesetzt werden. Die kammartige Anordnung unterstützt mit Vorteil die Verbindungstechnik unter Verwendung von industriell eingesetzten Platinenstecker-Buchsen zum Prüfen und Betreiben der gefertigten Elemente

15

In einer bevorzugten Ausführungsform sind mindestens ein erstes und mindestens ein zweites Korpuskularstrahlsystem mit Mess- und Stabilisatorschaltungen versehen, die zum Messen und Stabilisieren von Korpuskularstrahlung dienen.

20

Es werden ferner in einer bevorzugten Ausführungsform Schaltungselemente vorgesehen, welche die Korpuskularstrahlsysteme mit Spannung und Strom versorgen und

es ermöglichen, diese mittels Speicher programmierbar einzustellen. Dies ermöglicht den Aufbau sehr flexibler, da programmierbarer Korpuskularstrahlsysteme.

5 Vorzugsweise sind die Korpuskularstrahlsysteme mit Mitteln versehen, die zum Ausführen eines automatisierten Prüfverfahrens ausgebildet sind, welches die Funktionsfähigkeit und Stabilität der Strahlung und der Bildaufnahme und Bildauswertung gewährleistet.

10 Die Korpuskularstrahlsysteme werden vorteilhafterweise mit bildanzeigenden Mitteln verbunden, die in einem Bildschirm oder Großbildschirm mit entsprechender Bildaufteilung für die einzelnen Korpuskularstrahlsysteme 15 bestehen, so dass die Arbeit des Systems überwacht und sein Ergebnis für anderweitige Weiterverwendung zur Verfügung gestellt wird.

20 Die bildanzeigenden Mittel weisen insbesondere dateninformationsreduzierende Routinen auf, um die Überwachung zu unterstützen und um zu gewährleisten, dass im We sentlichen nur Fehler gespeichert werden müssen.

25 Vorzugsweise weisen die Korpuskularstrahlsysteme Elektronenquellen oder Gas- oder Flüssigkeitsionenquellen auf.

30 Schließlich betrifft die Erfindung die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens und/oder der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Herstellung von ebenen verteilten Bauelementen, insbesondere einer Widerstandsmatrix für eine flache Kamera, eines Flachbildschirms mit Korpuskularstrahlquellen, von Linsenarrays und einer

Schreib-/Leseanordnung für einen Speicher, sowie andere bereits oben genannte Anwendungen.

Weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der vor-  
5 liegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit den in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen.

In der Beschreibung, in den Ansprüchen, der Zusammen-  
10 fassung und in den Zeichnungen werden die in der hinten angeführten Liste der Bezugszeichen verwendeten Begriffe und zugeordneten Bezugszeichen verwendet.

In den Zeichnungen bedeutet:

15 Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen sukzessiven Herstellung von miniaturisierten Elektronenstrahlsystemen mit Hilfe vorgefertigter Schaltkreise und Elektronenstrahl-induzierter Deposition zum Aufbau funktionaler Gruppen von Korpuskularstrahlsystemen,

20 25 Fig. 2 eine schematische Darstellung eines einzelnen Elektronenstrahlsystems, das auf einer vorgegebenen Fläche auf einem Substrat durch Elektronenstrahl-induzierte Deposition gemäß der Erfindung aufgebaut wurde,

30 Fig. 3 eine Seitenansicht eines Elektronenstrahlsystems, dessen Strahlachse senkrecht zum Substrat angeordnet ist,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 3 dargestellten Elektronenstrahlsystems,

5 Fig. 5 die verschiedenen Potentiale im Elektronenstrahl, der von dem in den Fig. 3 und 4 dargestellten Elektronenstrahlsystem emittiert wird,

10 Fig. 6 eine Draufsicht auf das in Fig. 3 dargestellte Elektronenstrahlsystem,

15 Fig. 7 ein Gitter zur Ablenkkalibrierung und daneben ein mittels Elektronenstrahl-Deposition erzeugter Zylinderaufbau zur Bildung eines Faraday-Käfigs zur Strommessung, und

20 Fig. 8 eine Detailansicht des in Fig. 7 dargestellten Gitters mit den in Fig. 7 dargestellten Zylinderaufbauten.

Im folgenden können gleiche und funktional gleiche Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sein.

25 Eine Besonderheit des erfindungsgemäßen Verfahrens ist durch den Einsatz einer rechnergesteuerten Elektronenstrahl-induzierten Deposition gekennzeichnet. So kann beispielsweise in ca. 20-30 Min. auf einem vorbereiteten ersten Basis-Chip als erstes Substrat, der Stabilisierungs-, Steuer-, Auswertungs- und andere Schaltkreise aufweist, ein miniaturisiertes Elektronenstrahlsystem hergestellt werden. Die hierfür eingesetzte Herstellungstechnik ist eine Reparaturtechnik, welche die

Korrektur und Fehlerbehebung in den deponierten Strukturen ermöglicht. Mit dieser Technik wird ein erstes Elektronenstrahlsystem aufgebaut und danach durch Anlegen von erforderlichen Versorgungsspannungen eingeschaltet. Nach dem Einschalten erfolgt ein elektronischer Test des erzeugten Systems.

Die durch Deposition gefertigten Elemente des ersten Elektronenstrahlsystems wie elektrostatische Linsen und ein Abbildungssystem, das mit einer Strahlablenkung und mit oder ohne eine Aperturblende ausgerüstet ist, ermöglichen eine Fokussierung mit hoher Strahlstromdichte in einem geringen Arbeitsabstand. Dadurch wird es ermöglicht, durch eine Elektronenstrahl-induzierte Deposition weitere Bauelemente von Elektronenstrahlsystemen auf einem zweiten Basis-Chip als zweites Substrat abzuscheiden.

Um ein zweites Elektronenstrahlsystem aufzubauen, wird der zweite Basis-Chip durch mechanische Plazierung bzw. Anordnung gegenüber dem ersten Basis-Chip mit nm-Präzision ausgerichtet. Durch bildverarbeitende Mittel werden dann im Mix- und Match-Verfahren die Elektroden des zweiten Elektronenstrahlsystems auf Nanometer genau plaziert auf dem zweiten Basis-Chip hergestellt. So wird ein eine Quelle, einen Kondensor, eventuell eine Blende, ein Ablenksystem, eine Ablenklinse und einen Detektor umfassendes zweites Elektronenstrahlsystem erzeugt, das in seiner Gesamtgröße zwischen 1 und 100  $\mu\text{m}$  lang ist.

Dieses miniaturisierte Elektronenstrahlsystem ermöglicht eine Fokussierung eines Elektronenstrahls durch

die letzte Linse des Systems mit 20 bis 100 eV in einem Arbeitsabstand von einigen  $\mu\text{m}$ . Die Fokussierung kann dabei so fein werden wie bei einem herkömmlichen 20 kV-Elektronenstrahlsystem, da Linsenfehler der elektrostatischen miniaturisierten Linsen aus leitenden Drähten sehr viel kleiner sind, als die der herkömmlichen großen elektrischen und magnetischen Linsen in einem 20 kV-Elektronenstrahlsystem. Dementsprechend sind die Bildfehler um Größenordnungen kleiner. Ein derartiges miniaturisiertes Elektronenstrahlsystem ermöglicht daher bei ähnlich großer Apertur eine ähnliche Auflösung wie bei einem herkömmlichen etwa 1 m großen Elektronenstrahlsystem.

15 Die erfindungsgemäße Herstellung vieler miniaturisierter Elektronenstrahlsysteme wird mit Vorteil durch eine roboterartige Führung der Substrate, auf denen die Systeme aufgebaut werden, verbessert. Hierzu gibt es zwei unterschiedliche Verfahren.

20 Bei einem ersten Verfahren wird ein herkömmliches Raster-Elektronenstrahlsystem verwendet, das mit einer speziellen mehrkanaligen Gaszuführung zur Lieferung von Präkursoren für die Deposition ausgerüstet ist. Das Raster-Elektronenstrahlsystem erzeugt auf einem spezifischen Basis-Chip eines ersten Substrats für ein herzustellendes Elektronenstrahlsystem eine Elektrodenkonfigurationen, eine Elektronenquelle, eventuell eine Blende, eine Ablenklinse und einen Detektor durch Aufwachsen in vorbereitete Anschlusspunkte des spezifischen Basis-Chips. Dieses Elektronenstrahlsystem wird nun verwendet, um auf einem weiteren vorbereiteten Basis-Chip auf gleiche Weise, nämlich durch Depositions-

25

30

Schreiben senkrecht zum Substrat ein zweites Elektronenstrahlsystem aufzubauen. Beide Chips werden dann parallel angeordnet, mit Spannung versorgt und zu einer Doppelschreibeinheit verbunden. Mit einem derartigen

5 Doppelsystem können zwei weitere Elektronenstrahlsysteme aufgebaut werden. Insgesamt können so  $2^n$  Elektronenstrahlsysteme bei  $n$  Systemgenerationen hergestellt werden.

10 Ein zweites Verfahren besteht darin, auf einem ersten, kammartigen Substrat, das eine Vielzahl von kammartig angeordneten Basis-Chips aufweist, mit einem Raster-Elektronenstrahlsystem ein erstes Elektronenstrahlsystem auf einem der Basis-Chips zu erzeugen. Dem ersten Substrat wird dann ein zweites, ähnlich kammartig ausgebildetes Substrat gegenübergestellt, genauer gesagt in einem Winkel von etwa  $90^\circ$  zum ersten Substrat angeordnet. Das zweite Substrat wird dann mechanisch relativ zum ersten Substrat derart bewegt, dass mittels des

15 ersten Elektronenstrahlsystems auf dem ersten Substrat die Elektronenquelle, die Elektroden und weitere Systemfunktionselemente eines zweiten Elektronenstrahlsystems auf dem zweiten Substrat erzeugt werden.

20

25 Wenn dieses zweite „Tochter“-Elektronenstrahlsystem erzeugt ist, wird es ebenfalls wie das erste Elektronenstrahlsystem mit Strom versorgt und dazu benutzt, um auf einem zweiten Basis-Chip des ersten Substrats ein weiteres erstes Elektronenstrahlsystem aufzuschreiben,

30 nachdem das erste Substrat mechanisch relativ zum zweiten Substrat derart angeordnet worden ist, dass dem zweiten „Tochter“-Elektronenstrahlsystem eine freie Fläche bzw. ein Basis-Chip gegenüberliegt.

Danach befinden sich auf dem ersten Substrat zwei parallel angeordnete Elektronenstrahlsysteme, die wiederum zum Erzeugen zweier zweiter Elektronenstrahlsysteme 5 auf dem zweiten Substrat verwendet werden. Hierzu schreiben die beiden parallelen Elektronenstrahlsysteme des ersten Substrats auf das etwa rechtwinklig zum ersten Substrat angeordnete zweite Substrat zwei weitere Systeme, so dass sich auf dem zweiten Substrat insgesamt 10 drei Systeme befinden. Diese drei Elektronenstrahlsysteme werden wiederum dazu verwendet, auf das erste Substrat zusätzliche drei Elektronenstrahlsysteme zu erzeugen, so dass sich insgesamt fünf Systeme auf dem ersten Substrat befinden.

15 In Fig. 1 sind ein erstes und ein zweites Substrat 14 bzw. 16 dargestellt, auf denen sich erste bzw. zweite miniaturisierte Elektronenstrahlsysteme 10, 10', 10'', 10''', 10'''' bzw. 12, 12', 12'' befinden. Die beiden 20 Substrate 14 und 16 sind kammartig ausgebildet, d.h. sie haben eine etwa rechteckförmige Ausbildung und sind in freie Flächen entsprechend Basis-Chips aufgeteilt, welche für Elektronenstrahlsysteme vorgesehen sind. Die Substrate 14 und 16 sind in einem Winkel von etwa 90° 25 zueinander angeordnet. Ihre Position wird von einem (Steuer-)Rechner 20 kontrolliert, der Piezoelemente 22 und 24 zum exakten Ausrichten der Substrate 14 und 16 ansteuert. Damit ist eine Positionierung der Substrate 14 und 16 möglich, aber mit nm- Genauigkeit.

30 Die Elektronenstrahlsysteme 10-10'''' und 12-12'' wurden gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren folgendermaßen erzeugt: zuerst wurde mit einem nicht dargestellten

Raster-Elektronenschreiber das erste Elektronenstrahl-  
system 10 auf dem ersten Substrat 14 mittels Elektro-  
nenstrahl-induzierter Deposition hergestellt. Anschlie-  
ßend wurde das zweite Substrat 16 vom Rechner 20 über  
5 das Piezoelement 24 derart zum ersten Substrat 14 aus-  
gerichtet, dass der Basis-Chip für das zweite Elektro-  
nenstrahlsystem 12 gegenüber dem ersten Elektronen-  
strahlsystem 10 angeordnet war. Danach erzeugte das  
10 erste Elektronenstrahlsystem 10 das zweite Elektronen-  
strahlsystem 12. Das zweite Elektronenstrahlsystem 12  
wurde nach Fertigstellung in Betrieb genommen und er-  
zeugte nach erfolgreichem Test das erste Elektronen-  
strahlsystem 10' neben dem Elektronenstrahlsystem 10  
auf dem ersten Substrat, nachdem der entsprechende Ba-  
15 sis-Chip des ersten Substrats 14 gegenüber dem zweiten  
Elektronenstrahlsystem 12 plaziert worden war. Die bei-  
den nebeneinander liegenden Elektronenstrahlsysteme 10  
und 10' wurden dann zum gleichzeitigen Erzeugen der E-  
lektronenstrahlsysteme 12' und 12'' nach entsprechender  
20 Positionierung der beiden Substrate 14 und 16 erzeugt.  
Schließlich deponierten die so erzeugten nebeneinander  
angeordneten drei Elektronenstrahlsysteme 12-12'' die  
Elektronenstrahlsysteme 10''-10'''' gleichzeitig. In  
einem nächsten Schritt werden dann die Elektronen-  
strahlsysteme 10-10'''' gleichzeitig fünf (nicht darge-  
25 stellt) Elektronenstrahlsysteme auf dem zweiten Sub-  
strat 16 erzeugen. Die beiden Substrate 14 und 16 sind  
hierfür bereits entsprechend positioniert. Die Basis-  
Chips bzw. freien Flächen 18-18'''' für die zu erzeu-  
30 genden Elektronenstrahlsysteme auf dem zweiten Substrat  
sind noch frei.

Eine weitere freie Fläche am rechten Rand des ersten Substrats 14 zeigt schematisch Schaltungselemente 26, die für ein Elektronenstrahlsystem vorgesehen sind. Die Schaltungselemente 26 umfassen Verdrahtungselemente 28, 5 insbesondere Leiterbahnen, und Anschlusspunkte 34, insbesondere freie Metallflächen. Die Anschlusspunkte 34 dienen zum Aufwachsen von Strukturen eines Elektronenstrahlsystems, beispielsweise von Linsen und Blenden. Die Verdrahtungselemente 28 dienen zum elektrischen 10 Verbinden von einem Elektronenstrahlsystem mit weiteren (nicht dargestellten) Schaltungselementen, beispielsweise Strom- oder Spannungsquellen.

In Fig. 2 ist ein vollständiges Elektronenstrahlsystem 30 auf einer Fläche 32 eines Substrats dargestellt, wie es durch das erfindungsgemäße Verfahren auf einem Basis-Chip erzeugt wurde. Der von dem System 30 erzeugte Elektronenstrahl trifft auf ein Objekt 36, das beispielsweise ein weiterer Basis-Chip eines Substrats 20 sein kann, auf dem ein weiteres Elektronenstrahlsystem aufgebaut werden soll. Das Objekt 36 ist etwa in einem Winkel von 90° zum System 30 angeordnet und befindet sich etwa im Brennpunkt des Elektronenstrahls 34.

Das dargestellte Elektronenstrahlsystem 30 umfasst einen Emitter 38 sowie ein Blenden und Linsensystem 40 mit einer Extraktor-Linse aus zwei ringförmigen Elektroden. Eine Blende ist nicht gezeigt. Diese müsste in dem Raum zwischen Extraktorlinse und Ablenklinse angeordnet sein. Wegen der Anordnung der Feldelektroenenquelle als Superspitze auf dem Emitterträger kann es ausreichen, die auf einen Emissionsort begrenzte Emission ohne zusätzliche Blende vollständig zu verwenden.

den, da dies durch die kleinen Linsenfehler der Extraktorlinse ermöglicht ist, ohne die Quelle in ihrer Größe und Emittanz wesentlich zu verschlechtern. Zudem kann der Fokus des Strahls durch den Rundlinsenateil der Ab-  
5 lenklinse geregelt werden. Ein derartiges Elektronen-  
strahlsystem 30 wird dazu verwendet, ein „Tochter“- E-  
lektronenstrahlsystem auf dem Objekt 36 mittels Elekt-  
ronenstrahl-induzierter Deposition gemäß der Erfindung  
zu erzeugen.

10

Mit den oben beschriebenen Verfahren entsteht eine spe-  
zielle mathematische Reihe von Wachstumszahlen und von  
Elektronenstrahlsystemen, welche auch ähnlich dem expo-  
nentiellen Wachstum zu einer Reproduktion von vielen  
15 Elektronenstrahlsystemen führt. Das erfindungsgemäße  
Verfahren hat den Vorteil, dass zwei funktionsfähige  
Substrate sukzessive mit Elektronenstrahlsystemen er-  
gänzt aufgefüllt werden, und zum Schluss sehr schnell  
voll gefüllte Substrate mit Elektronenstrahlsystemen  
20 erhalten werden. Um beispielsweise 64 oder 1024 oder  
gar 1 Mio. von miniaturisierten Elektronenstrahlsyste-  
men zu erhalten, können die Substrate mit ihren paral-  
lel arbeitenden Elektronenstrahlsystemen als ganzes  
eingesetzt werden und neue „Tochter“-  
25 Elektronenstrahlsysteme auf einem neuen Substrat  
gleichzeitig herstellen.

Das zweite Verfahren hat gegenüber dem ersten Verfahren  
den Vorteil, dass die Substrate mit Elektronenstrahl-  
30 systemen nicht in Einzelemente zerschnitten werden  
müssen. Ausserdem ist mit Vorteil die Verdrahtung der  
Versorgungsspannungen und anderer parallel ablaufender  
elektrischer Steuerungs-Schritte mit in das Substrat

bei der Herstellung integriert. Damit wird das Packaging von Einzelkomponenten vermieden und die Zuverlässigkeit der Anordnung wesentlich erhöht.

5 In Fig. 3 ist ein erstes Elektronenstrahlsystem 10 auf einem ersten Substrat 14 in seitlicher Ansicht dargestellt, dessen durch eine gestrichelte Linie angedeuteter Elektronenstrahl etwa senkrecht zum Substrat 14 verläuft. Der Elektronenstrahl des ersten Systems 10  
10 baut auf einem zweiten Substrat 16, das dem ersten Substrat 14 gegenüberliegt, ein zweites Elektronenstrahlsystem 12 mittels Elektronenstrahl-induzierter Deposition auf. Zwischen den beiden plattenförmigen Substraten 14 und 16 befindet sich ein Gas, dessen Gaspartikel  
15 58 für die Deposition erforderlich sind. Das Gas weist einen für die Deposition ausreichend hohen Druck zwischen den Substraten 14 und 16 auf.

Das erste Elektronenstrahlsystem 10 umfasst eine feine Metallspitze als Emitter 38 für Elektronen. Weiterhin weist das erste System 10 einen ersten Quadrupol mit den Quadrupol-Elektroden 44 und einen zweiten Quadrupol mit den Quadrupol-Elektroden 50 und 52 auf. Die entsprechend zum Quadrupol gehörigen weiteren zwei Elektroden in der zur Zeichenebene senkrechten Ebene durch die Strahlachse sind nicht gezeichnet, werden aber in den folgenden Figuren 4 im Schrägbild für den ersten Quadrupol und in Figur 6 mit ihren Fußpunkten an den Endpunkten der Anschlussleiterbahnen 43, 44, 46, 48 und  
25 50 - 56 in der Anschlussstruktur dargestellt. Der erste Quadrupol 43, 44, (46, 48 nicht gezeigt) dient als Extraktor, um die vom Emitter 38 emittierten Elektroden zu beschleunigen. Der zweite Quadrupol 50, 52, (54, 56  
30

nicht gezeigt) ist in Richtung vom ersten zum zweiten Substrat 14 bzw. 16 hinter dem ersten Quadrupol 43, 44 angeordnet und dient als Fokussierungslinse für den Elektronenstrahl. Mittels einer rechnergesteuerten Einstellung der Versorgungsspannung der Elektroden der beiden Quadrupole 43, 44, 50, 52 wird der Emissionsstrom des Emitters 38, die Fokussierung und Ablenkung des Elektronenstrahls in x-y-Richtung ermöglicht, wobei die x-y-Ebene etwa parallel zu den Ebenen liegt, in welchen sich die Substrate 14 und 16 befinden. Fig. 4 zeigt das in Fig. 3 dargestellte erste Elektronenstrahlsystem 10 in perspektivischer Ansicht. Neben den Elektroden 50, 52, 54, 56 des zweiten Quadrupols ist der Emitter 38 zu erkennen. Der erste Quadrupol von Fig. 3 ist in dieser Ansicht nicht dargestellt.

Fig. 5 zeigt das Potential eines von einem Emitter 38 emittierten Elektronenstrahls. An der Spitze des Emitters 38 herrscht ein Potential  $Q_1$ . Wenn der Elektronenstrahl aus dem Elektronenstrahlsystem austritt weist er ein Potential  $Q_2$  auf, das im Wesentlichen vom zweiten Quadrupol bestimmt wird. Der Elektronenstrahl trifft auf das zweite Substrat 16 mit einem Bremspotential auf. Diese Verzögerung der Primärelektronen bewirkt eine Beschleunigung der aus dem Substrat ausgelösten Sekundärelektronen und bremst die dort ausgelösten Ionen, so dass sie nicht die Feldemissionskathode erreichen können. In einer weiteren vorteilhaften Ausführung können die Potentialwerte  $Q_1$  und  $Q_2$  auch vertauscht sein und dennoch das Bremspotential erhalten bleiben.

In Fig. 6 ist das Elektronenstrahlsystem 10 in Draufsicht dargestellt. In dieser Darstellung sind alle

Elektroden des Systems zu erkennen. Der erste Quadrupol wird durch die Elektroden 43, 44, 46, 48 und der zweite Quadrupol durch die Elektroden 50, 52, 54, 56 gebildet. Die Ansteuerung der Elektroden ist beispielhaft für die 5 Elektrode 48 dargestellt. Sie umfasst für die Elektrode 48 eine einstellbare Spannungsquelle 60, die über ein Strom-Messgerät 62 mit der Erde verbunden ist. Über die einstellbare Spannungsquelle 62 kann das Potential der Elektrode 48 eingestellt werden. Die Elektroden 50, 52, 10 54 und 56 werden auch als Fänger für Sekundärelektronen verwendet. Alle Signale der Elektroden 50, 52, 54 und 56 werden mit einem Summierverstärker anstelle dem Einzelnen Strom-Messgerät pro Elektrode, wie bei 48 exemplarisch dargestellt, addiert und zur Bildauswertung 15 verwendet. Damit kann der Aufbau des zweiten Elektronenstrahlsystems 12 auf dem zweiten Substrat 16 visuell überwacht werden, indem ein mit der x-y Ablenkung synchron laufender Schreibstrahl einer Bildwiedergaberöhre in seiner Helligkeit mit dem verstärkten Sekundärelektronensignal moduliert wird. 20

Fig. 7 zeigt ein Gitter 64 zur Ablenkkalibrierung von Elektronenstrahlen. Dieses Gitter 64 kann auch zur Messung des Astigmatismus durch ein Moiré-Verfahren eingesetzt werden, indem die Elektronensonde unter einem sehr kleinen Winkel zur Gittersteg-Kante geführt wird und aus der Zahl der im Sekundärelektronensignal sichtbaren Querstege auf den benötigten Weg geschlossen wird, um die Sonde ganz auf den Steg zu fahren oder 25 ganz vom Steg zu bewegen. Die Auflösung des Verfahrens ist proportional zu  $1 / \text{Winkel zwischen Sondenbewegungsrichtung und Gittersteg}$ . Wie mit dem Gitter eine 30 Messung und Kalibrierung des Astigmatismus erfolgt, ist

in der Veröffentlichung „Metrology-Chip for Measurement of Diameter and Astigmatism of an Electron Beam with nm Resolution Using Moiré Amplification“, H.W.P. Koops, B.Hübner, M.Watanabe, Microelectronic Engineering 23 5 (1994) S.387-390, genauer beschrieben. Das Gitter 64, das Quer- und Längsstäbe 66 bzw. 68 umfasst, ist auf einem Substrat angeordnet und dient im wesentlichen als Kalibermuster und Detektorfläche zur Strommessung. Es weist den in Fig. 7 rechts neben dem Gitter 64 dargestellten Zylinder 70 auf. Der Zylinder 70, dessen Höhe sehr viel größer als sein Durchmesser ist, ist mittels Deposition erzeugt worden. Der Zylinder bildet einen Faraday-Käfig zur Strommessung und ist hierzu mit Leiterbahnen 72 des Gitters 64 kontaktiert.

15 Die in Fig. 8 dargestellte Detailansicht des Gitters 64 zeigt, wie die Zylinder 70 im Gitter angeordnet sind.

Das Wachstum der Vielzahl von Elektronenstrahlsystemen 20 gemäß der Erfindung ermöglicht den Einsatz vieler lokal, separat geführter Elektronenstrahlsysteme für die Fertigung mittels Elektronenstrahl-induzierter Deposition. Durch die Größe dieser miniaturisierten Systeme wird eine Strahldichte im Bereich von etwa 250 µm und darunter als Strahlabstand längs eines kammförmigen 25 Substrats erreicht. Durch Aufeinanderlegen von derartig mit Elektronenstrahlsystemen versehenen Substraten wird ein Abstand der Strahlen senkrecht zum Kamm von wiederum z.B. etwa 250 µm erreicht, bzw. der die Steuerelektronik tragenden Halbleiterdicke. Das entspricht der Dicke eines Silizium-Wafers, aus welchen die Substrate 30 mit Basis-Chips gefertigt wurden. Diese Strahldichte von etwa 250 x 250 µm Abstand in einer Fläche von etwa

30 mm x 30 mm ermöglicht 1440 Strahlen, die zur Herstellung von eben verteilten Bauelementen, die mit einem derartigen Rastermaß gebraucht werden, eingesetzt werden.

5

Beispielsweise kann die Rastermatrix zur Herstellung einer Widerstandsmatrix für eine flache Kamera mit Elektronenstrahl-induzierter Deposition eingesetzt und diese in Massenproduktion hergestellt werden. Eine weitere vorteilhafte Anwendung derartiger Parallelstrahl-Systeme dient der Herstellung von Flachbildschirmen mit Elektronenquellen. Die Elektronenquellen bestehen hierbei je aus Emitter und Extraktor. Damit müssen nur zwei Drahtelektroden hergestellt werden, von welchen eine eine feine Spitze hat. Dies gilt auch für die Herstellung von Linsenarrays durch Elektronenstrahlbelichtung und anderen eben in einem Rastermaß geforderten Depositions- und Belichtungsstrukturen. Zum weiteren können derartige Systeme, da sie eigenständige Detektoren beinhalten, auch zum Vermessen von Strukturen in paralleler Anordnung der Elektronenstrahlen verwendet werden. Auf diese Weise kann der Durchsatz der Elektronenstrahlmesstechnik in der Halbleiterfertigung mit hoher Auflösung vervielfacht werden.

25

Zudem ist das Schreiben von Elektronenstrahllithographiestrukturen mit viel höherer Schreibgeschwindigkeit mit einem mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Elektronenstrahlsystem-Array möglich, da verhindert wird, dass der Gesamtelektronenstrom durch eine Optik fließt. Bei den im Raster angeordneten Elektronenstrahlsystemen fließt dagegen der Elektronenstrahlstrom durch  $2^n$  Optiken (wenn n Generationen von Elektro-

ronenstrahlsystemen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gemäß dem oben beschrieben ersten oder zweiten Verfahren hergestellt wurden). Dadurch kann man die Schreibzeit  $t$  auf  $t/2^n$  verringern, was für die Großflächenlithographie insbesondere für Nanostrukturen von großem Vorteil ist, beispielsweise beim direkten Schreiben von Masken oder Wafer-Belichtungen für die Produktion von integrierten Schaltungen.

10 Eine weitere vorteilhafte Anwendung der Vielzahl von Elektronenstrahlsystemen liegt in der Speichertechnik. Dazu werden Elektronenstrahlsysteme so aufgebaut, daß sie durch Ablenkung ihres Elektronenstrahls in einem Rasterfeld von beispielsweise etwa  $100 \mu\text{m} \times 100 \mu\text{m}$  die 15 Speicherelemente, zum Beispiel elektrische oder magnetische Speicherzellen-Elemente von etwa 30 nm Durchmesser herstellen und auch ansprechen können. Durch geeignete Auswertung der Strahl-Antwort in Form von rückgestreuten oder gespiegelten Elektronen kann der Speicherzelleninhalt gelesen und eine Speicherung der Information ohne die Verwendung beweglicher Teile ermöglicht werden. In der Fläche von etwa  $100 \mu\text{m} \times 100 \mu\text{m}$  können sich beispielsweise 9 Millionen Speicherzellen befinden. Mit z.B. 1000 parallel arbeitenden Elektronenstrahlsystemen, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt wurden, wären 9 Gbit ansprechbar. 20 Zudem kann durch die Verwendung von parallel arbeitenden Schreib- und Lesestrahlen die Datenübertragungsrate gegenüber herkömmlichen Speichersystemen wie beispielsweise DRAM-Chips oder auch Festplatten erhöht werden. 25 Gleichzeitig wird der Einsatz mechanisch bewegter Teile vermieden, was die Zuverlässigkeit der Anordnung erhöht.

5

## B E Z U G S Z E I C H E N L I S T E

10	10-10''''	erste Elektronenstrahlsystem
	12-12''	zweite Elektronenstrahlsysteme
14		erstes Substrat
16		zweites Substrat
	18-18''''	freie Flächen
15	20	Rechner
	22, 24	Piezoelemente
26		Schaltungselemente
28		Verdrahtungselemente
30		Elektronenstrahlsystem
20	32	Fläche
	34	Anschlusspunkte
36		Objekt
38		Emitter
40		Linsensystem
25	42	Extraktor-Linse
	43	Elektrode des ersten Quadrupols (Extraktor-Linse)
44		Elektrode des ersten Quadrupols (Extraktor-Linse)
30	46	Elektrode des ersten Quadrupols (Extraktor-Linse)
	48	Elektrode des ersten Quadrupols (Extraktor-Linse)

50	Elektrode des zweiten Quadrupols (Fokusier- und Ablenk-Linse)
52	Elektrode des zweiten Quadrupols (Fokusier- und Ablenk-Linse)
5 54	Elektrode des zweiten Quadrupols (Fokusier- und Ablenk-Linse)
56	Elektrode des zweiten Quadrupols (Fokusier- und Ablenk-Linse)
58	Gaspartikel
10 60	einstellbarer Spannungsquelle
62	Strom-Messgerät
64	Gitter
66	Querstäbe
68	Längsstäbe
15 70	Zylinder (Faraday-Käfig)
72	Leiterbahn

5

## P A T E N T A N S P R Ü C H E

10 1. Verfahren zur Herstellung von Korpuskularstrahlsystemen (10-10''', 12-12''), bei dem auf einem ersten Substrat (14) mindestens ein erstes Korpuskularstrahlsystem (10) mittels korpuskularstrahlinduzierter Deposition und auf mindestens einem zweiten Substrat (16) mindestens ein zweites Korpuskularstrahlsystem (12) von dem mindestens einen ersten Korpuskularstrahlsystem (10) mittels rechnergeföhrter korpuskularstrahlinduzierter Deposition erzeugt wird.

15

20 2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass anschliessend auf dem ersten Substrat (14) mindestens ein weiteres erstes Korpuskularstrahlsystem (10') von dem mindestens einen zweiten Korpuskularstrahlsystem (12) mittels rechnergeföhrter korpuskularstrahlinduzierter Deposition erzeugt wird.

25

30 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass abwechselnd erste und zweite Korpuskularstrahlsysteme (12', 12'', 10'', 10''', 10''''') von den bereits auf den Substra-

ten (14, 16) existierenden zweiten bzw. ersten Korpuskularstrahlsystemen erzeugt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass das erste und das zweite Substrat (14, 16) derart zueinander versetzt angeordnet werden, dass den auf einem Substrat (14) bereits existierenden Korpuskularstrahlsystemen (10-10'') freie Flächen (18-18'') des anderen Substrats (16) gegenüberliegen, so dass die Korpuskularstrahlsysteme (10-10'') des einen Substrats (14) Korpuskularstrahlsysteme auf den freien Flächen (18-18'') des anderen Substrats (16) erzeugen können.

5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Substrate (14, 16) von einem Rechner (20) gesteuert positioniert werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Substrate (14, 16) mittels Piezoelementen (22, 24) zueinander positioniert werden.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass jedes Korpuskularstrahlsystem (10-10'', 12-12'') nach seiner Erzeugung elektrisch getestet wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass vor der Erzeugung von Korpuskularstrahlsystemen auf den Sub-

straten Schaltungselemente (26), insbesondere Verdrahtungselemente (28) erzeugt werden, mit denen Korpuskularstrahlsysteme zumindest teilweise elektrisch verbunden werden.

5

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass Korpuskularstrahlsysteme auf Anschlusspunkten (34), die auf einem Substrat (14) vorgesehen sind, erzeugt werden.

10

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass Korpuskularstrahlsysteme auf einem Substrat kammartig nebeneinander angeordnet werden.

15

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass erste und/oder zweite Korpuskularstrahlsysteme eine Bildauswertung von Bildsignalen, die durch Rasterung erzeugt werden, durchführen.

20

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass sowohl Fokussierung, Stigmatisierung und Ablenkung eines Korpuskularstrahls in einem automatischen Ablauf erfolgen und für jedes Korpuskularstrahlsystem eine individuelle Fokussierung durchgeführt wird.

25

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deposition mit rechnergeführter Ionenstrahl-induzierter o-

30

der Elektronenstrahl-induzierter Deposition durchgeführt wird.

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Deposition für das erste herzustellende Korpuskularstrahl-  
5 system mit rechnergeführter rastersondenmikro-  
skopischer Deposition mit Niederspannung von et-  
wa 100 V bis etwa 40 kV erfolgt.

10 15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Korpusku-  
larstrahlsysteme in Gruppen von einem Steuersys-  
tem umfassend eine Steuer- und Programmierelekt-  
ronik 15 angesteuert und kontrolliert werden.

20 16. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Korpusku-  
larstrahlsysteme bis zu einer bestimmten Anzahl vollständig konfiguriert aufgebaut und dann  
durch geeignete Zuführung von Gasen zum Aufbau weiterer Korpuskularstrahlsysteme als parallel  
arbeitende Blöcke von Korpuskularstrahlsystemen verwendet werden.

25 30 17. Verfahren nach Anspruch 16, **dadurch ge- kennzeichnet**, dass Einzelkämme von Korpusku-  
larstrahlsystemen reproduziert und zu Ferti-  
gungssystemen zusammengesetzt und konfiguriert werden.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, **dadurch ge- kennzeichnet**, dass die Blöcke gemeinsam produ-

ziert werden, ohne dass sie weiterhin zusammen-  
gesetzt werden müssen.

19. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-  
5 che, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Korpusku-  
larstrahlsysteme (siehe Figuren 3 bis 6) mit ih-  
ren Strahlachsen etwa senkrecht zur Oberfläche  
des Substrats angeordnet sind.

10 20. Vorrichtung zur Herstellung von Korpusku-  
larstrahlsystemen (10-10\*\*\*\*, 12-12\*\*), mit ei-  
nem ersten Substrat (14) und mindestens einem  
zweiten Substrat (16), wobei sich auf dem ersten  
Substrat (14) mindestens ein mittels Rechnerge-  
15 führter Korpuskularstrahl-induzierter Deposition  
erzeugtes erstes Korpuskularstrahlsystem (10-  
10\*\*\*\*) befindet.

20 21. Vorrichtung nach Anspruch 19, **dadurch gekenn-**  
**zeichnet**, dass das erste und das mindestens  
zweite Substrat (14, 16) derart zueinander ver-  
setzt angeordnet sind, dass den auf einem Sub-  
strat (14) bereits existierenden Korpusku-  
larstrahlsystemen (10-10\*\*\*\*) freie Flächen (18-  
18\*\*\*\*) des anderen Substrats (16) gegenüberlie-  
gen, so dass die Korpuskularstrahlsysteme (10-  
15 10\*\*\*\*) des einen Substrats (14) Korpusku-  
larstrahlsysteme auf den freien Flächen (18-  
18\*\*\*\*) des anderen Substrats (16) erzeugen kön-  
nen.

25 30 22. Vorrichtung nach Anspruch 20, **gekennzeichnet**  
**durch** einen Rechner (20), der programmtechnisch

eingerichtet ist, um die Anordnung der Substrate (14, 16) zu steuern.

23. Vorrichtung nach Anspruch 21, **gekennzeichnet durch** Piezoelemente (22, 24) an den Substraten (14, 16), um diese rechnergeführt und nach Bildauswertung der Abbildung der freien Fußpunkte zueinander zu positionieren.

10 24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 22, **gekennzeichnet durch** Testmittel, wie Bildwiedergabe, elektrische Strom- und Sekundärelektronendetektion und Anzeige, und andere Anzeigen, die zum Testen jedes Korpuskularstrahlsystems (10-10'', 12-12'') auf den Substraten (14, 16) ausgebildet sind.

20 25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass das erste und zweite Substrat (14, 16) ein Halbleiter, insbesondere Silizium ist.

25 26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass das erste und zweite Substrat (14, 16) ein Nichtleiter, insbesondere Glas, Keramik oder Quarz ist.

30 27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Substrat Schaltungselemente (26), insbesondere Verdrahtungselemente (28) aufweist, mit denen Korpuskularstrahlsysteme zum mindest teilweise elektrisch verbunden sind.

28. Vorrichtung nach Anspruch 25, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schaltungselemente insbesondere rechnergesteuerte Korpuskularstrahlstromregler, Heizstromregler, Korpuskularstrahlablenkverstärker, Blendenablenkverstärker, Rastergenerator, Funktionsgenerator mit Speicher, Linseneinstellmittel, Linsenspannungsverstärker, Bildsignalverstärker, Astigmatismus-  
5 Spannungsverstärker und/oder Ablenkungsspannungsverstärker umfassen.

10

29. Vorrichtung nach Anspruch 25, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schaltungselemente insbesondere Rechner-Bausteine wie Zentraleinheit, Rechen-Speicher, Puffer-Speicher, Datenspeicher, und in Hardwaregespeicherte Routinen ausführende Schaltungen sind, die zur Reproduktion der Systeme, der Bilderfassung und Auswertung und zur Herstellung spezieller neuartiger Systeme benötigt werden und diese ermöglichen.  
15

20

30. Vorrichtung nach Anspruch 29, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schaltungselemente die zur Reproduktion der Systeme, der Bilderfassung und Auswertung und zur Herstellung spezieller neuartiger Systeme benötigt werden und diese ermöglichen im Multiplex-verfahren auf die einzelnen fertigenden Korpuskularstrahlsysteme zu deren Steuerung sequentiell aufgeschaltet werden können.  
25

30

31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 29,  
dadurch gekennzeichnet, dass ein Substrat min-  
destens eine Fläche (32) mit einer Breite von  
etwa 2 µm bis etwa 2500 µm und einer Länge von  
etwa 10 µm bis zu etwa 100 mm für ein Korpusku-  
larstrahlsystem (30) aufweist.

5

32. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 27,  
dadurch gekennzeichnet, dass ein Substrat (14)  
10 Anschlusspunkte (34) für Korpuskularstrahlsyste-  
me aufweist.

33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 28,  
dadurch gekennzeichnet, dass Korpuskularstrahl-  
15 systeme auf einem Substrat kammartig nebeneinan-  
der angeordnet sind.

34. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 29,  
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein ers-  
20 tes und mindestens ein zweites Korpusku-  
larstrahlsystem mit Mess- und Stabilisatorschal-  
tungen versehen sind, die zum Messen und Stabi-  
lisieren von Korpuskularstrahlung dienen.

25 35. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 30,  
dadurch gekennzeichnet, dass Schaltungselemente  
vorgesehen sind, welche die Korpuskularstrahl-  
systeme mit Spannung und Strom versorgen und  
mittels Speicher programmierbar und einstellbar  
30 sind.

36. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 31,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Korpusku-

larstrahlsysteme mit Mitteln versehen sind, die zum Ausführen eines automatisierten Prüfverfahrens ausgebildet sind, welches die Funktionsfähigkeit und Stabilität der Strahlung und der Bildaufnahme und Bildauswertung gewährleistet.

5

37. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 32, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Korpuskularstrahlsysteme mit bildanzeigenden Mitteln verbunden sind, wie einem Bildschirm oder Großbildschirm mit entsprechender Bildaufteilung für die einzelnen Korpuskularstrahlsysteme, so dass die Arbeit des Systems überwacht und sein Ergebnis für anderweitige Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden kann.

10

15

38. Vorrichtung nach Anspruch 33, **dadurch gekennzeichnet**, dass die bildanzeigenden Mittel dateninformationsreduzierende Routinen aufweisen, um die Überwachung zu unterstützen, und die gewährleisten, dass im Wesentlichen nur Fehler gespeichert werden müssen.

20

25

39. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 34, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Korpuskularstrahlsysteme Elektronenquellen oder Gas- oder Flüssigkeitsionenquellen aufweisen.

25

30

40. Verwendung eines Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18 und/oder einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 39 zur Herstellung von ebenen verteilten Bauelementen, insbesondere einer Widerstandsmatrix für eine flache Kamera,

eines Flachbildschirms mit Korpuskularstrahl-  
quellen, von Linsenarrays, von Hochstrom-  
Emitter-Arrays mit niedriger Schaltspannung zur  
Steuerung des Stromes, von mikro-  
5 Elektronenröhren aller Arten und einer Schreib-  
/Leseanordnung für einen Speicher.

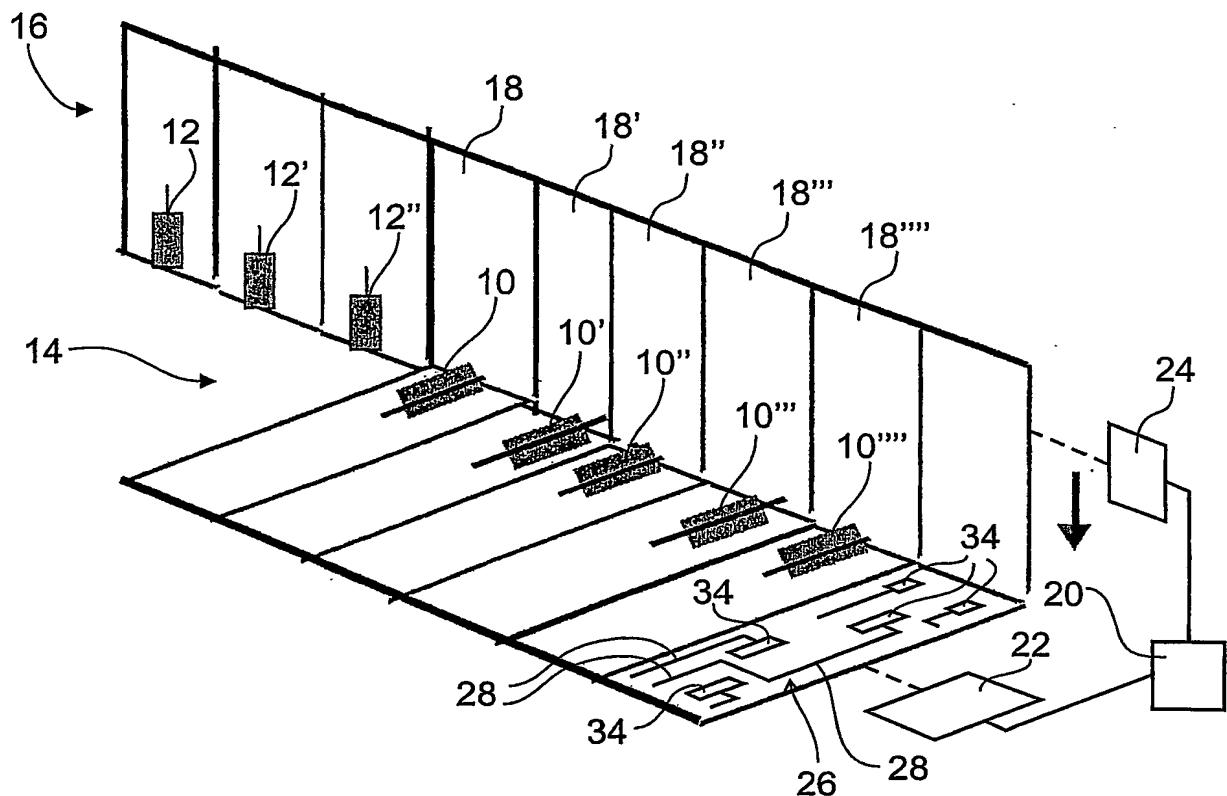


Fig. 1

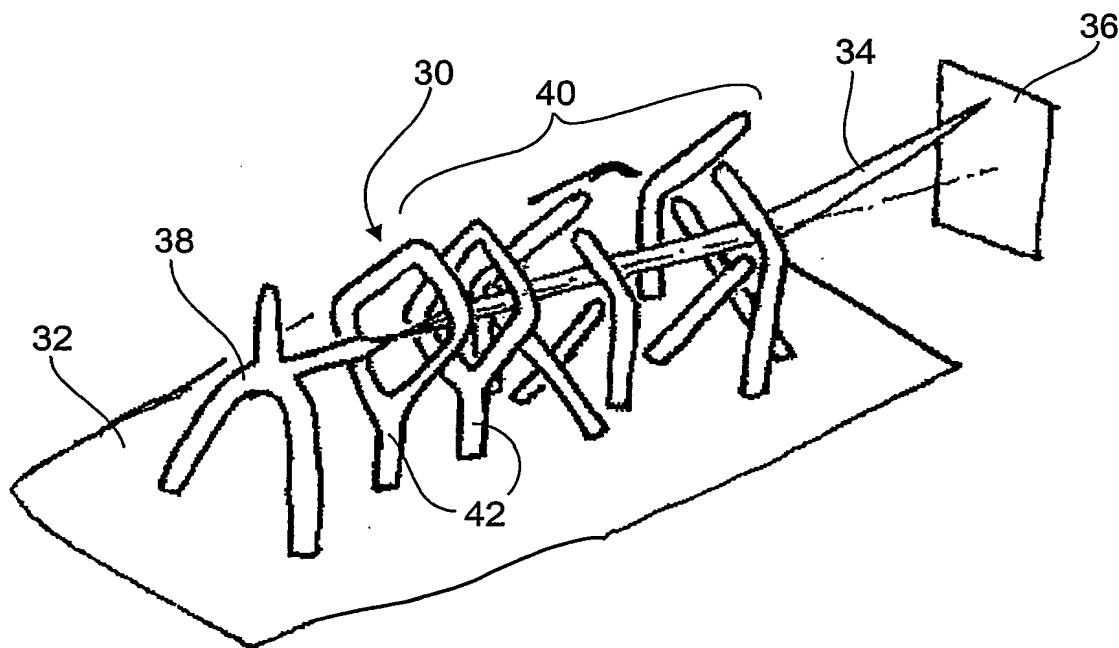


Fig. 2

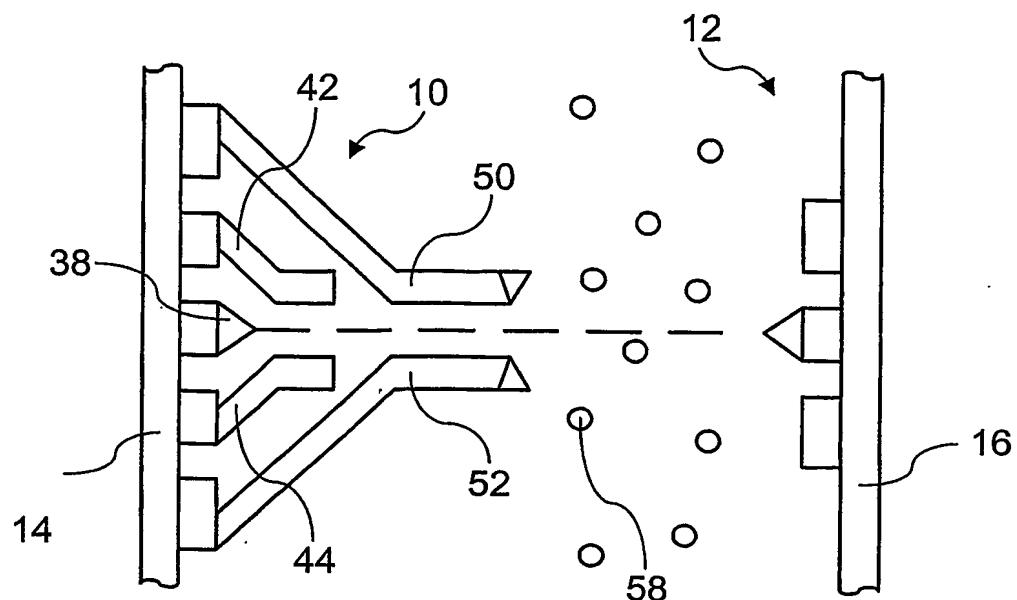


Fig. 3

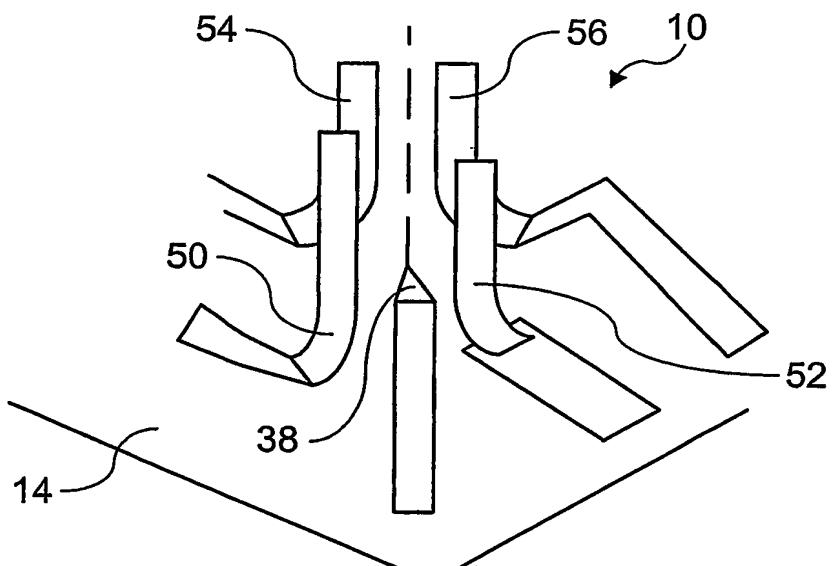


Fig. 4

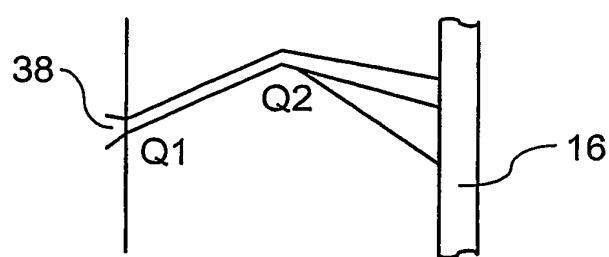


Fig. 5

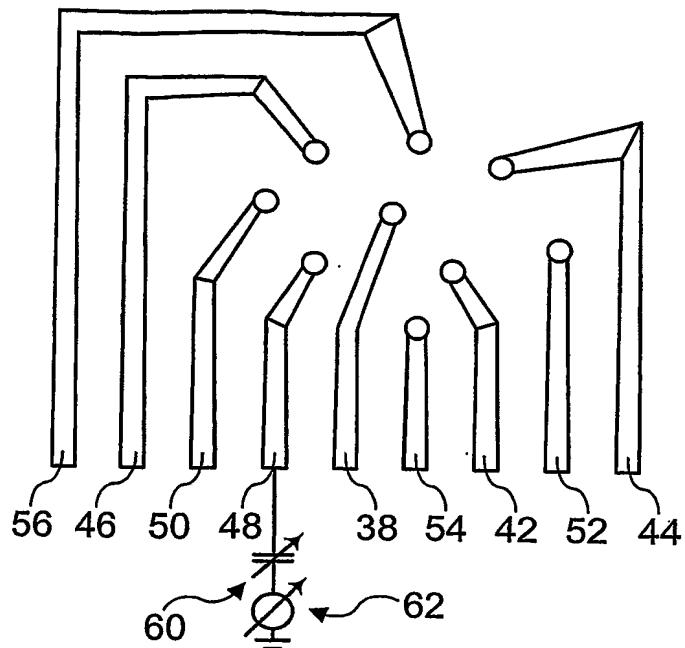


Fig. 6

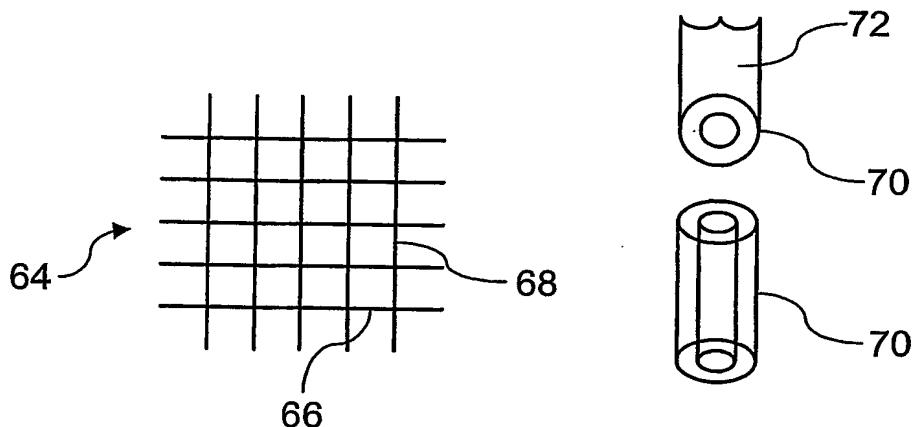


Fig. 7

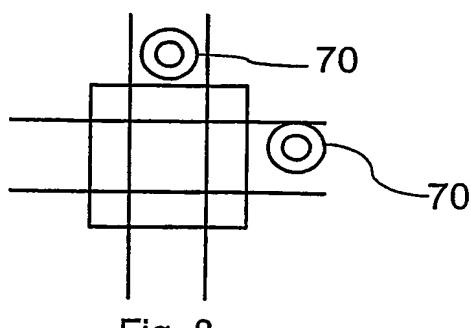


Fig. 8

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image  
problems checked, please do not report these problems to  
the IFW Image Problem Mailbox.**